### 03,05

# Структурное и магнитное упорядочение монокристаллов CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>, выращенных методом газового транспорта

© Е.Б. Борисенко<sup>1</sup>, В.А. Березин<sup>2</sup>, Н.Н. Колесников<sup>1</sup>, В.К. Гартман<sup>1</sup>, Д.В. Матвеев<sup>1</sup>, О.Ф. Шахлевич<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка, Россия <sup>2</sup> Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, Черноголовка, Россия E-mail: borisenk@issp.ac.ru

#### (Поступила в Редакцию 28 декабря 2016 г.)

Парамагнитный слоистый полупроводник NbS2, легированный некоторыми переходными металлами, может превращаться в ферромагнитный материал. Поэтому такие материалы являются перспективными для ипользования в спинтронике. Установлено, что только при определенных концентрациях легирующего металла Т оказывается возможным кристаллографическое упорядочение, которое является существенным для магнитного упорядочения тройных соединений TNbS<sub>2</sub>. В частности, изучены кристаллы CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>, которые формировали практически полностью упорядоченную сверхструктуру с интеркалированными атомами Сг между слоями NbS2. Основной трудностью при выращивании этих кристаллов является достижение стехиометрии соединения. Эта проблема решена путем использования разработанного метода двухстадийной химической газовой транспортной реакции. Этот новый подход обеспечивает рост монокристаллов CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> размером несколько миллиметров в диаметре и толщиной 0.3-0.5 mm. Проведен рентгенофазовый анализ порошков для идентификации всех фаз, участвующих в синтезе и росте кристаллов. Высокочастотное поглощение во внешнем периодическом магнитном поле как функция температуры и напряженности магнитного поля использовано для оценки температуры ферромагнитного перехода монокристаллов CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>. Значение температуры Кюри оценено как 115 К. Подробно исследован рост монокристаллов CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> из паровой фазы и дан полный анализ фазовых переходов в процессе роста. Показано, что применение высокочастотного поглощения в кристалле позволяет надежно определять точку ферромагнитного превращения в этом полупроводнике.

Авторы выражают благодарность Отделению физических наук РАН за финансовую поддержку исследований в рамках программы "Физика новых материалов и структур" (проект № 00-12-10).

DOI: 10.21883/FTT.2017.07.44588.464

#### 1. Введение

Дихалькогениды некоторых переходных металлов привлекают внимание исследователей с 1970-х годов благодаря своим сверхпроводящим, металлическим, полупроводниковым и диэлектрическим свойствам. Слоистые структуры таких полупроводников, как NbS<sub>2</sub>, NbSe<sub>2</sub>, TaS<sub>2</sub> и др., обеспечивают возможность внедрения переходного металла в их структуры. Магнитные свойства соединений на основе NbS2, содержащих переходные металлы, изменяются от ферромагнитных до антиферромагнитных в ряду легирующих металлов от Mn до Ni [1–3]. Известно, что некоторые соединения со стехиометрическими составами образуют сверхструктуры с дальним порядком, что представляет особый интерес в связи с их ферромагнитными свойствами. В ряду  $T_x$ NbS<sub>2</sub> (T = Mn, Fe, Co, Ni) сверхрешетки формируются при концентрации металла x = 1/3 или 1/4 [1]. Во всех остальных случаях в процессе кристаллизации образуются неупорядоченные твердые растворы, которые не проявляют ферромагнитных свойств. Структуры и некоторые физические свойства синтезированных порошков  $TNb_3S_6$  и  $TNb_4S_8$  были исследованы в [1].

Ранее монокристаллы CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> были выращены методом химического газового транспорта и исследованы с помощью дифракции нейтронов [2].

Несмотря на то что этот материал известен довольно давно, остается проблема выращивания однофазных кристаллов определенного стехиометрического состава. В настоящей работе рассмотрено выращивание монокристаллов CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> методом газотранспортной реакции в потоке газа I2 и исследован вопрос получения кристаллов стехиометрического состава и того, как избежать присущего этому методу смешения фаз  $CrNb_3S_6$  и  $CrNb_4S_8$ . Впервые методом рентгенофазового анализа порошков исследованы все фазы, образующиеся в процессе синтеза и двухстадийного выращивания кристаллов. Для исследования структуры выращенных кристаллов использовалась дифрактометрическая съемка монокристаллов. Различные магнитные методы, применяемые ранее для определения температуры Кюри соединения CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> [1,3-5] давали отличающиеся друг от друга значения температур ферромагнитного перехода. В связи с этим был разработан и применен новый метод оценки температуры ферромагнитного перехода, основанный на температурной и полевой зависимостях высокочастотного  $(B \ensuremath{ \mathbf{W}})$  поглощения в кристаллах  $CrNb_3S_6$  в переменном магнитном поле.

### 2. Материалы и методики

Из исходных порошков NbS<sub>2</sub> и Cr<sub>6</sub>S<sub>7</sub> (чистота компонентов: S — 99.9999%, Nb — 99.8%, Cr — 99.9%) было синтезировано соединение CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>. Синтез проводился в печи при температуре 1073 K в течение недели в запаянной кварцевой ампуле при давлении 10 Ра. Полученный порошок был использован для выращивания кристаллов методом газового транспорта с I<sub>2</sub> (плотностью 2 kg/m<sup>3</sup>) в качестве транспортного агента при температурах 1123–1173 К. Рост монокристаллов CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> осуществлялся в две стадии, каждая из которых длилась 24 h в одинаковых условиях.

Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) проводился на растровом электронном микроскопе (РЭМ) SUPRA 50V с приставкой INCA Energy+ для микроанализа с использованием энергодисперсионного спектрометра. Было исследовано несколько участков площадью  $5 \times 5 \,\mu$ m, разброс экспериментальных значений ~ 2%.

Дифрактограммы были получены на рентгеновском дифрактометре Siemens D500 с использованием излучения Cu $K_{\alpha 1}$  в диапазоне углов от 10 до 100° с шагом 0.02°. Фазовый анализ был проведен на основе известных рентгеновских баз данных с помощью программ EVA, Powder Cell и МАТСН. Точность измерения параметров решетки составила около  $3 \cdot 10^{-4}$  nm, чувствительность метода ~ 2 vol.% для каждой фазы. Дифрактометр Gemini-R с CCD-детектором был использован для дифрактометрии монокристаллов. Использовалось излучение Мо $K_{\alpha 1}$ , точность измерения параметров элементарной ячейки  $5 \cdot 10^{-4}$  nm.

Чтобы получить температурную зависимость ВЧ-поглощения в кристалле в переменном магнитном поле, мы использовали схему "резонатор с образцом", разработанную и описанную в [6]. Образец помещался в спиральный резонатор, плоскость образца была параллельна оси резонатора, внешнее магнитное поле прикладывалось перпендикулярно или параллельно образцу. Резонансная частота колебательного контура с образцом составляла около 700 MHz. Отклонение направления внешнего магнитного поля от нормали к плоскости образца было не более 5°. Измерения ВЧ-потерь проводились по схеме проходного спектрометра с использованием генератора качающейся частоты для исключения влияния дисперсии частоты резонатора. В нашем случае частот, далеких от частот магнитных резонансов, основной вклад в сигнал вносят потери от наведенного ВЧ-тока, протекающего в образце, и потери на перемагничивание образца ВЧ-полем. Данный подход был использован, в частности, в работе [7]. Образцы охлаждались жидким азотом, который заливался в рубашку криостата. Температура измерялась угольным термометром с точностью около 1 К.



**Рис. 1.** РЭМ-изображение синтезированного порошка CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>.



Рис. 2. Дифрактограмма порошка CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>.

## 3. Результаты и обсуждение

Порошок, синтезированный из соединений  $NbS_2$  и  $Cr_6S_7$ , оказался неоднородным по составу и размеру частиц. Согласно данным РСМА (рис. 1), он в основном состоял из частиц  $CrNb_3S_6$ , но также содержал  $Cr_6S_7$ .

Данные рентгенофазового анализа подтверждают, что порошок в основном состоит из гексагональной фазы CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> с пространственной группой  $P6_322$  (22-0350 JCPDS) и также содержит следы гексагональной фазы Cr<sub>6</sub>S<sub>7</sub> (09-273 JCPDS) с пространственной группой P (рис. 2).

В результате испарения в потоке газа  $I_2$  порошки различных составов осаждаются в горячей и холодной зонах. Порошки из горячей зоны в основном состоят из фазы CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> и содержат до 3 vol.% гексагонального CrNb<sub>4</sub>S<sub>8</sub> (30-0819 JCPDS). Порошок из холодной зоны практически полностью состоит из CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>. Данные PCMA показывают, что помимо этих фаз присутствуют частицы иодидов хрома-ниобия, которые очень быстро окисляются на воздухе.



Рис. 3. Монокристаллы CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>.



**Рис. 4.** Дифрактограмма порошка размолотого монокристалла CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>.

Для проведения второй стадии газотранспортной реакции порошок, осажденный на первой стадии, собирали из холодной зоны и снова испаряли при тех же условиях. К концу этой стадии вырастали пластинчатые кристаллы размером несколько миллиметров с толщиной сотни микрометров (рис. 3).

Данные рентгенофазового анализа (рис. 4) указывают на то, что пластинки представляют собой однофазные кристаллы CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> с параметрами элементарной ячейки a = 0.5737 nm, c = 1.212 nm, что находится в хорошем согласии с нейтронографическими данными [1]. Рентгеновская съемка на дифрактометре Gemini-R показала, что выращенные пластинки — монокристаллы с практически полностью упорядоченной сверхрешеткой CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> с ориентацией [0001] и параметрами кристаллической решетки a = 0.574 nm, c = 1.213 nm, которые находятся в хорошем согласии с данными порошковой дифрактометрии. РСМА показал однородное распределение компонентов по сечению, соответствующее составу CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>.

На рис. 5 показана полевая зависимость ВЧ-потерь при температуре 77 К для двух ориентаций магнитного поля по отношению к плоскости образца. Угловая зависимость ВЧ-поглощения для ориентации магнитного поля практически параллельной плоскости образца очень резкая, отклонение на 1° приводит к значительному изменению амплитуды ВЧ-поглощения в конечном поле, что было использовано для юстировки образца. В параллельной и перпендикулярной ориентировке образца относительно внешнего поля имеются различия в области малых полей, что указывает на разницу в доменной структуре для этих двух случаев. В больших полях обе зависимости выходят на насыщение, характерное поле этого насыщения уменьшается с ростом температуры. Характер поведения полевой зависимости ВЧпоглощения позволяет утверждать, что основной вклад в полезный сигнал вносят потери на перемагничивание образца ВЧ-магнитным полем, а величина сигнала определяется магнитной структурой образца.

Температурная зависимость ВЧ-поглощения была измерена при одновременно периодически изменяющемся внешнем магнитном поле. Этот подход был использован в [7] для исследования фазовых превращений в



**Рис. 5.** Зависимость ВЧ-поглощения в монокристалле  $CrNb_3S_6$  от магнитного поля T = 77 К.



**Рис. 6.** Зависимость ВЧ-поглощения в монокристалле  $CrNb_3S_6$  от температуры в периодически изменяющемся магнитном поле *H* при частоте f = 720 MHz.

высокотемпературных сверхпроводниках. Как оказалось, он дает точную оценку температуры перехода, что используется в настоящей работе для оценки температуры Кюри T<sub>c</sub> монокристалла CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>. Каждый период изменения магнитного поля происходит практически при одной температуре, а весь набор таких зависимостей при постепенном смещении по температуре образует наглядную картину происходящих изменений. Пример такой записи приведен на рис. 6. Верхняя огибающая соответствует температурной зависимости ВЧ-поглощения в нулевом поле. Для простоты картины приведена запись в параллельном поле. Прекращение влияния внешнего магнитного поля происходит при температуре выше 115 К. Такая же оценка Т<sub>с</sub> справедлива и для перпендикулярной ориентировки магнитного поля. Монотонное изменение ВЧ-поглощения выше этой температуры связано с температурной зависимостью сопротивления образца и резонатора. Разделения вкладов каждой из

При более ранних измерениях температуры ферромагнитного перехода в порошках  $CrNb_3S_6$  с помощью вибрационного магнитометра [1] были найдены значения температуры Кюри 170 К. Позднее  $T_c$  монокристаллов  $CrNb_3S_6$  была получена из температурных зависимостей намагниченности [3]. Межслойное магнитосопротивление вдоль оси *с* дало значение температуры Кюри монокристаллов 132 К [4]. Исследования спин-релаксации  $\mu$ -мюонов в монокристаллах  $CrNb_3S_6$  дали оценку  $T_c$ около 127 К [5].

Различия в измеренных значениях  $T_c$  могут быть связаны с разной чувствительностью использованных методов и более высоким структурным совершенством наших монокристаллов CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub>, чистотой их химического и фазового состава.

#### 4. Заключение

этих причин не проводилось.

Монокристаллы CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> были выращены методом газового транспорта. Потребовались две стадии газотранспортной реакции с использованием I<sub>2</sub> в качестве транспортного агента для получения однофазных монокристаллов из синтезированных порошков. Показано, что выращенные кристаллы имеют гексагональную структуру с параметрами элементарной ячейки a = 0.574 nm, c = 1.213 nm. Температурная зависимость ВЧ-поглощения в переменном магнитном поле на резонансной частоте 720 MHz указывает на ферромагнитное упорядочение в монокристаллах CrNb<sub>3</sub>S<sub>6</sub> и дает нижнюю оценку температуры Кюри  $T_c = 115$  K.

#### Список литературы

- E. Mooser. In: Intercalated layered materials / Eds F. Lévy, D. Reidel. Publishing Company, Dordrecht-Boston-London (1979). P. 251.
- [2] T. Ueno, K. Yamamoto, H. Matsukura, T. Kusawake, K. Ohshima. Sci. Technol. Adv. Mater. 6, 684 (2005).

- [3] T. Miyadi, K. Kikuchi, H. Kondo, S. Sakka, M. Arai, Y. Ishikawa. J. Phys. Soc. Jpn. 52, 4, 1394 (1983).
- [4] Y. Togawa, Y. Kousaka, S. Nishihara, K. Inoue, J. Akimitsu, A.S. Ovchinnikov, J. Kishine. Phys. Rev. Lett. 111, 19, 197204 (2013).
- [5] D. Braam, C. Gomez, S. Tezok, E.V.L. de Mello, L. Li, D. Mandrus, H.-Y. Kee, J.E. Sonier. Phys. Rev. B 91, 144407 (2015).
- [6] В.А. Березин, В.А. Тулин. ЖЭТФ 110, 1054 (1996).
- [7] В.А. Березин, К.В.Багинский, В.А. Тулин, Д.А. Шулятев, Я.М. Муковский. Письма в ЖТФ 27, 1, 25 (2001).